

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

4-е заседание Председатель – Терещенко О.Е.

9⁰⁰ – 9³⁰

С.А.Бабин^{1,2}, М.И.Скворцов¹, А.А.Вольф¹,

А.В.Достовалов¹, С.Р.Абдуллина¹, А.А.Власов¹.

Волоконные лазеры с распределенной обратной связью на основе регулярных и случайных структур показателя преломления (**приглашенный доклад**)(*on-line*).

¹ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.* А.В.Галеева¹, А.С.Казаков¹, А.И.Артамкин¹,

9³⁰ – 9⁴⁵

Н.Н.Михайлов¹, С.А.Дворецкий^{1,3}, Р.В.Меньшиков¹, В.Г.Ремесник¹, И.Н.Ужаков¹, В.А.Швец^{1,2}.

МЛЭ рост сложных фотоприёмных, лазерных и nВп структур на основе твердых растворов CdHgTe.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Томский государственный университет, Томск.*

9⁴⁵ – 10⁰⁰

И.И.Кремис, Р.А.Гладков, А.С.Турбин, Е.А.Крапивко, П.А.Алдохин, В.С.Калинин, В.В.Васильев, А.А.Моисеев.

Малогабаритная тепловизионная камера с микросканированием на базе отечественного матричного КРТ фотоприемника.

Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ».

10⁰⁰ – 10¹⁵

В.А.Голяшов^{1,2}, Д.А.Кустов¹, В.С.Русецкий^{2,3}, Т.С.Шамирзаев^{1,2}, А.В.Миронов², А.Ю.Демин², В.В.Аксенов², О.Е.Терещенко^{1,2}.

Оптический детектор спина свободных электронов с пространственным разрешением на основе полупроводниковых гетероструктур.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

$10^{15} - 10^{30}$ $10^{30} - 10^{45}$ $10^{45} - 11^{00}$ $11^{00} - 11^{30}$	<p>³ ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск.</p> <p><u>С.А.Кузнецов</u>^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, П.А.Лазорский¹, В.Н.Федоринин¹, А.В.Аржанников^{2,3}, Н.А.Николаев^{2,4}, А.А.Мамрашев⁴, А.А.Рыбак^{2,4}, А.Н.Генцелев³, В.П.Бессмельцев⁴.</p> <p>Высокоэффективные квазиоптические частотные фильтры ТГц диапазона на основе частотно-избирательных поверхностей.</p> <p>¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск;</p> <p>² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;</p> <p>³ Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск;</p> <p>⁴ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.</p> <p><u>Ф.А.Минаков</u>, А.А.Мамрашев, В.Д.Анцыгин, Н.А.Николаев.</p> <p>Поляризационно-чувствительная терагерцовая спектроскопия анизотропных кристаллов.</p> <p>Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.</p> <p><u>В.Н.Федоринин</u>¹, С.А.Кузнецов^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, А.Ю.Горшков¹.</p> <p>Эллипсометрия субмиллиметрового диапазона в задачах диагностики композиционных материалов.</p> <p>¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск;</p> <p>² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.</p> <p>Кофе-брейк</p>
--	--

5-е заседание Председатель – Сидоров Г.Ю.

11³⁰ – 12⁰⁰

М.В.Якунин¹, С.М.Подгорных¹, А.В.Суслов²,
С.С.Криштопенко³, B.Jouault³, W.Desrat³, F.Terpe³,
В.Н.Неверов¹, М.Р.Попов¹, Н.Н.Михайлов⁴,
С.А.Дворецкий⁴.

Исследования энергетического спектра
квазидвумерных структур HgTe/CdHgTe
магнитотранспортными методами (**приглашенный
доклад**).

¹ Институт физики металлов им. М.Н. Михеева
УрО РАН, Екатеринбург;

² National High Magnetic Field Laboratory, Florida State
University, Tallahassee, Florida, USA;

³ Laboratoire Charles Coulomb, Centre National de la
Recherche Scientifique, University of Montpellier,
Montpellier, France;

⁴ Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.

12⁰⁰ – 12¹⁵

Д.В.Горшков, В.С.Варавин, Г.Ю.Сидоров,
В.Г.Ремесник, И.В.Сабинина.

Восстановление р-типа проводимости HgCdTe после
плазмохимического травления при низких
температурах.

Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.

12¹⁵ – 12³⁰

А.В.Кацюба¹, А.В.Двуреченский^{1,2}, Г.Н.Камаев¹,
В.А.Володин^{1,2}.

Формирование пленки CaSi₂ в условиях
радиационного воздействия на структуру CaF₂/Si.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет,
Новосибирск.

12³⁰ – 12⁴⁵

Д.М.Ежов, Е.С.Савельев, Е.Д.Фахрутдинова,
В.А.Светличный.

Использование магнитных наночастиц в устройствах
управления ТГц излучением.

Томский государственный университет, Томск.

12 ⁴⁵ – 13 ⁰⁰	<i>В.В.Васильев, А.В.Вишняков, Г.Ю.Сидоров, В.А.Стучинский.</i> Определение частотно-контрастной характеристики ИК объективов. <i>Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.</i>
13 ⁰⁰ – 13 ¹⁵	<i>М.В.Дорохин¹, М.В.Ведь¹, П.Б.Дёмин¹, Д.В.Хомицкий¹, К.С.Кабаев¹, F.Iikawa², M.A.G.Balanta², Б.Н.Звонков¹</i> Циркулярно-поляризованная фотолюминесценция в nanoструктурах InGaAs/GaAs, дельта-легированных Mn. ¹ <i>Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород;</i> ² <i>Instituto do Fisica “Gleb Watagin”, Campinas, Brazil</i>
13 ¹⁵ – 14 ³⁰	Обед

6-е заседание Председатель – Морозов С.В.

14 ³⁰ – 15 ⁰⁰	<u>М.М.Глазов</u> Экситоны и трионы в оптическом отклике двумерных кристаллов (приглашенный доклад). <i>Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.</i>
15 ⁰⁰ – 15 ³⁰	<u>С.В.Гапоненко</u> Перспективы коллоидной оптоэлектроники (приглашенный доклад) (on-line). <i>Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь</i>
15 ³⁰ – 15 ⁴⁵	<u>В.С.Попов^{1,2}, В.П.Пономаренко^{1,2}, П.И.Абрамов¹.</u> Фотоэлектроника на основе коллоидных наноматериалов. ¹ <i>Государственный научный центр РФ АО «НПО «Орион», Москва;</i> ² <i>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный.</i>

15⁴⁵ – 16⁰⁰

А.С.Голтаев¹, А.М.Можаров¹, В.В.Ярошенко²,
Д.А.Зуев², И.С.Мухин¹.

Исследование однофотонной излучающей системы
на основе NV-центров в наноалмазах,
интегрированных с ННК GaP.

¹ Академический университет им. Ж.И. Алфёрова,
Санкт-Петербург;

² ИТМО, Санкт-Петербург.

16⁰⁰ – 16¹⁵

В.А.Холоднов^{1,2}.

О возможности регулирования фотоэлектрического
отклика полупроводников специальным
пространственным профилированием потока
излучения.(on-line)

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова РАН, Москва;

² ОАО «НПО «Орион», Москва.

16¹⁵ – 16³⁰

Кофе-брейк

16³⁰ – 18³⁰

Стендовая сессия - 2